

交叉学科

离子注入制备量子光电材料的研究

谢二庆^{1、2}, 王志光¹, 金运范¹

1 中国科学院近代物理研究所;

2 兰州大学物理系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

对由量子限域效应引起的硅纳米晶粒的强烈光致发光现象、离子注入技术制备量子光电材料及其在光电子器件应用领域的优势和前景作了评述和探讨.

The strong photoluminescence (PL) of Si nanocrystals originated from the quantum confined effect, the preparation of quantum optoelectronic material by ion implantation as well as the advantages if its application to optoelectronic devices are reviewed and discussed.

关键词 [离子注入](#) [硅纳米晶粒](#) [量子点材料](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [谢二庆^{1、2}](#); [王志光¹](#); [金运范¹](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (137KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“离子注入”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [谢二庆](#)

· [王志光](#)

· [金运范](#)